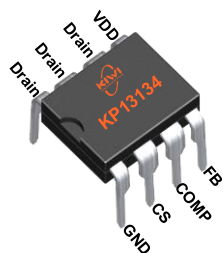


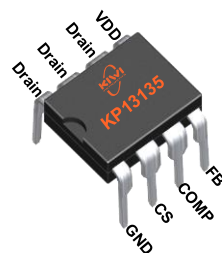
图 2: 实地三绕组典型应用电路图

必易微授权立创商城

### 管脚封装

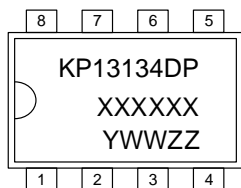


DIP-8



DIP-8

### 产品标记



DIP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份代码  
WW: 周代码, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ



DIP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
Y: 年份代码  
WW: 周代码, 01-52  
ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ

### 典型功率表

产品型号	产品封装	内阻	推荐最大功率
KP13134DP	DIP-8	2.1Ω	50W
KP13135DP	DIP-8	1.2Ω	60W

备注: 最大输出功率受限于芯片最高结温, 且与环境温度和 PCB 有关, 实际系统最大输出功率请以测试为准。

### 管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	GND	P	芯片参考地
2	CS	O	电流采样输入管脚
3	COMP	I	恒流控制功能管脚, 需在 COMP 与 GND 之间连接电容, 典型值推荐 1~22nF
4	FB	I	输出反馈管脚
5	VDD	P	芯片供电管脚
6, 7, 8	Drain	I	内部高压 MOSFET Drain 端

### 订货信息

型号	描述
KP13134DP	DIP-8, 无铅, 50 颗/管
KP13135DP	DIP-8, 无铅, 50 颗/管

**极限参数 (备注 1)**

参数	数值	单位
VDD 直流供电电压	25	V
VDD 直流箝位电流	30	mA
Drain 电压	-0.3 to 650	V
FB 电压范围	-0.7 to 7	V
CS、COMP 电压范围	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境 (DIP-8)	105	°C/W
P <sub>Dmax</sub> 耗散功率 @T <sub>A</sub> =50°C(DIP-8) (备注 2)	0.9	W
最大结温	150	°C
储藏温度范围	-65 to 150	°C
焊接温度 (焊接, 10 s)	260	°C
ESD 人体模型	3	kV

**推荐工作条件**

参数	数值	单位
工作结温	-40 to 125	°C

**电气参数 (T<sub>A</sub>= 25°C, VDD=18V, 除非另有说明)**

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>供电部分 (VDD 管脚)</b>						
I <sub>VDD_st</sub>	VDD 启动电流	VDD= V <sub>DD_ON</sub> -1V		2	20	μA
I <sub>VDD_Op</sub>	VDD 工作电流	VDD=20V		0.5	1	mA
V <sub>DD_ON</sub>	VDD 开启电压		15	16.3	17.5	V
V <sub>DD_OFF</sub>	VDD 关断电压		8	9	10	V
V <sub>DD_Clamp</sub>	VDD 箝位电压	I(V <sub>DD</sub> ) = 20 mA		25		V
<b>反馈控制部分 (FB 管脚)</b>						
V <sub>FB_OVP</sub>	输出过压保护阈值		1.38	1.4	1.42	V
V <sub>FB_SCP</sub>	输出短路保护阈值			0.3		V
T <sub>FB_Short</sub>	短路保护去抖时间			35		ms

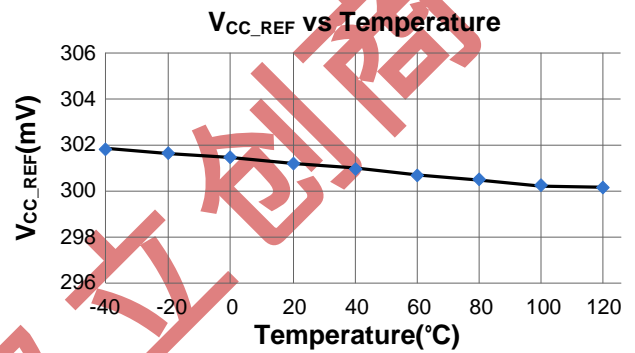
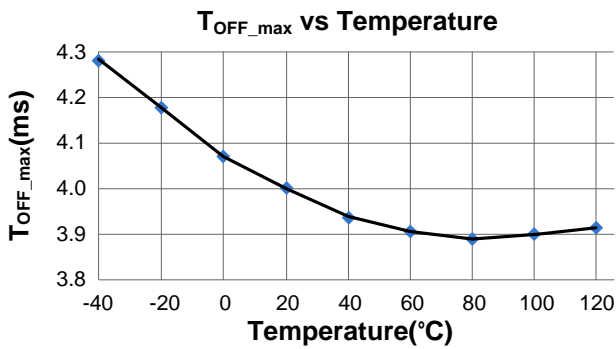
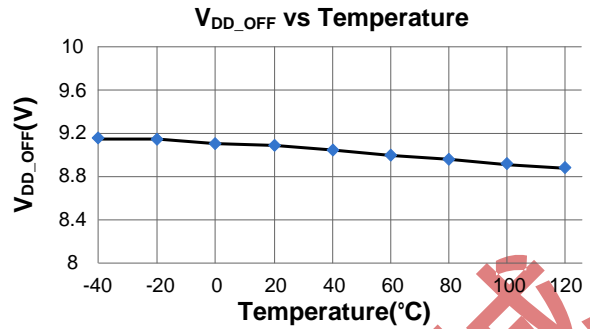
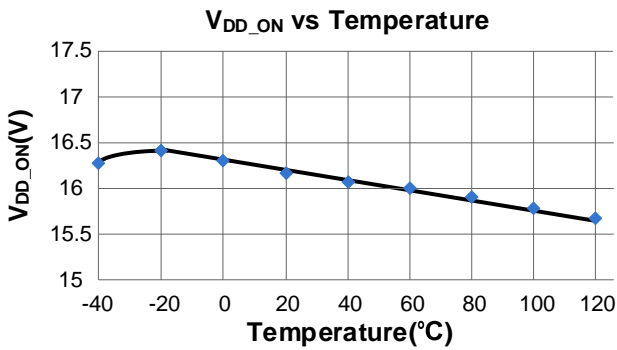
V <sub>FB_DEM</sub>	消磁比较器阈值	(备注 3)		-40		mV
T <sub>off_max</sub>	最长关断时间			4		ms
T <sub>on_max</sub>	最长导通时间		36	40	44	μs
T <sub>dem_blk</sub>	消磁检测消隐时间	(备注 3)	2.7	3	3.3	μs
F <sub>swmax</sub>	最高工作频率			100		kHz
<b>电流采样部分 (CS 管脚)</b>						
T <sub>LEB</sub>	前沿消隐时间	(备注 3)		500		ns
AOCP	过流保护阈值			1		V
V <sub>csmin</sub>	最小电流阈值			200		mV
V <sub>CC_REF</sub>	恒流环参考基准		297	300	306	mV
T <sub>D_OC</sub>	单周期电流关断延时	GATE=0.5nF (备注 3)		100		ns
<b>过温保护</b>						
T <sub>OTP</sub>	智能温度调节阈值	(备注 3)		150		°C
<b>功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)</b>						
V <sub>BR</sub>	功率 MOSFET 漏源击穿电压		650			V
R <sub>dson</sub>	导通电阻	KP13134DP		2.1	2.4	Ω
		KP13135DP		1.2	1.4	Ω

**备注 1:** 超出列表中极限参数可能会对芯片造成永久性损坏。极限参数为额定应力值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，会影响器件的可靠性。

**备注 2:** 超出上述工作条件不能保证芯片正常工作。

**备注 3:** 参数取决于设计，批量生产制造时通过功能性测试。

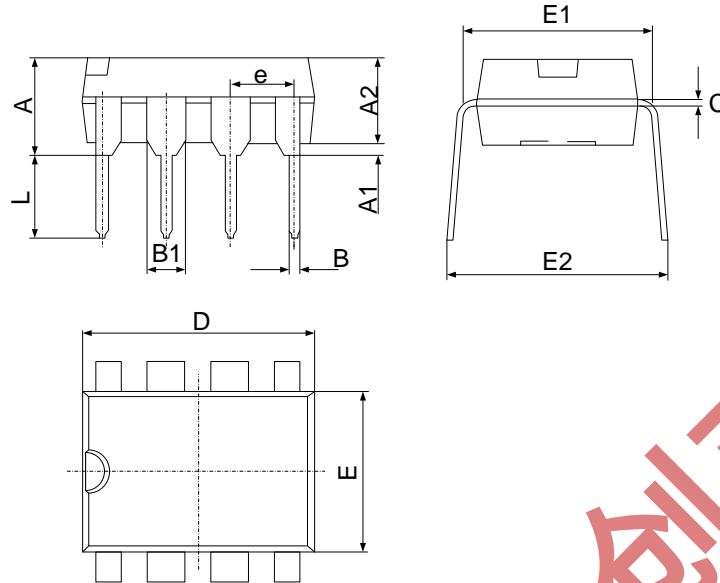
## 参数特性曲线



必易微授权代理商

## 封装尺寸

### DIP-8



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(中心到中心)		0.060(中心到中心)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(中心到中心)		0.100(中心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

## 声明

必易微确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易微的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易微不负任何法律责任。